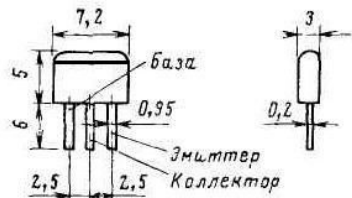


КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И

Предельные эксплуатационные данные

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* уси-
тельные высокочастотные маломощные.



Предназначены для работы
в схемах усилителей высокой,
промежуточной и низкой частоты

Выпускаются в пластмассо-
вом корпусе с гибкими выво-
дами Обозначение типа при-
водится на этикетке

Масса транзистора не более
0,18 г

Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_3 = 5$ мА не менее	
КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж	15 В
КТ315В, КТ315Д, КТ315И	30 В
КТ315Г, КТ315Е	25 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 20$ мА, $I_B = 2$ мА не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г	0,4 В
КТ315Д, КТ315Е	1 В
КТ315Ж	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 20$ мА, $I_B = 2$ мА не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г	1,1 В
КТ315Д, КТ315Е	1,5 В
КТ315Ж	0,9 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 10$ В, $I_K = 1$ мА	
КТ315А, КТ315Б, КТ315Д	20 – 90
КТ315Е, КТ315Г, КТ315Е	50 – 350
КТ315Ж	30 – 250
КТ315И не менее	30
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА не более	
КТ315А	300 нс
КТ315Б, КТ315В, КТ315Г	500 нс
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж	1000 нс
Модуль коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 10$ В, $I_K = 1$ мА, $f = 100$ МГц не менее	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315И	2,5
КТ315Ж	1,5
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315И	7 пФ
КТ315Ж	10 пФ
Входное сопротивление при $U_{КБ} = 10$ В, $I_K = 1$ мА не менее	
	40 Ом
Выходная проводимость при $U_{КБ} = 10$ В, $I_K = 1$ мА не более	
	0,3 мксм
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В не бо- лее	
	1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм, $U_{КБ} =$ $= U_{КЭ макс}$ не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е	1 мкА
КТ315Ж	10 мкА
КТ315И	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В не бо- лее	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж	30 мкА
КТ315И	50 мкА

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм	
КТ315А	25 В
КТ315Б	20 В
КТ315В, КТ315Д	40 В
КТ315Г, КТ315Е	35 В
КТ315Ж	15 В
КТ315И	60 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	
	6 В
Постоянный ток коллектора	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е	100 мА
КТ315Ж, КТ315И	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 213 - 298$ К	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е	150 мВт
КТ315Ж, КТ315И	100 мВт
Температура перехода	
	393 К
Температура окружающей среды	
	От 213 до 373 К

Примечания 1 Постоянная рассеиваемая мощность коллекто-
ра, мВт, при $T = 298 - 373$ К определяется по формуле

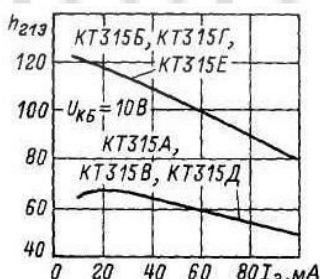
$$P_{К макс} = (393 - T)/0,67$$

Допускается эксплуатация транзисторов в режиме $P_K = 250$ мВт
при $U_{КБ} = 12,5$ В, $I_K = 20$ мА

2 Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм
от корпуса транзистора

При включении транзистора в схему, находящуюся под напря-
жением, базовый вывод должен подсоединяться первым и отсоеди-
няться последним

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах,
соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем интер-
вале температур



Зависимость статического коэф-
фициента передачи тока от тока
эмиттера

Зависимость напряжения насы-
щения коллектор-эмиттер от то-
ка коллектора

Зависимость напряжения насы-
щения база-эмиттер от тока
базы

